Under the Pao	RANSMITTAL FORM all correspondence after initial Pages in This Submission	Examiner Name Attorney Docket Number ADTP0085USA
Amendme Aft Aft Aft Aft Aft Extension Express A Informatio Certified C Document Response Incomplete	ter Final fidavits/declaration(s) of Time Request bandonment Request in Disclosure Statement Copy of Priority	Drawing(s) Licensing-related Papers Petition Petition to Convert to a Provisional Application Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address Terminal Disclaimer Request for Refund CD, Number of CD(s) After Allowance communication to Technology Center (TC) Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences Appeal Communication to TC (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) Proprietary Information Status Letter Other Enclosure(s) (please Identify below): Remarks
	Winston Hsu, Reg. I	IO.: 41,526 CONTROL OF TRANSMISSION/MAILING Ening facsimile transmitted to the USPTO or deposited with the United States Postal Service with elope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on

This collection of information is required by 37 CFR 1.5. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Signature

Date

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Signature

PTO/SB/17 (10-03)

Approved for use through 07/31/2006. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE work Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Date

Complete if Known

10/707,646

12/30/2003

FEE TRANSMITTAL Application Number Filing Date

for FY 2004

Effective 10/01/2003. Patent fees are su		First Named Inventor	Chun-Huai Li		
-		Examiner Name			
Applicant claims small entity status.	See 37 CFR 1.27	Art Unit			
TOTAL AMOUNT OF PAYMENT	(\$) 0.00	Attomey Docket No.	ADTP0085USA	-	

METH	MENT (check all the				FE	E CALCULAT	FION (continue	d)				
Check	Money O	3. Al	DDITI	ONAL	_ FEE	ES		7				
]			Order L	her None	<u>Large (</u>	Entity	Small	Entity	•			
Deposit	Account:	04			Fee Code		Fee Code	Fee (\$)	Fee C	Description		Fee Paid
Account Number	50-08	01			1051	130	2051	65	Surcharge - late	filing fee or oath		
Deposit Account	North A	merica	a International Pater	nt Office	1052	50	2052	25	Surcharge - late cover sheet	provisional filing fe	ee or	
Name The Director is	e authoria	od to:	(check all that apply)		1053	130	1053	130	Non-English spe	cification		
Charge fee				overpayments	1812	2,520	1812	2,520	For filing a reque	est for ex parte ree	xamination	
			or any underpayment		1804	920*	1804	920*	Requesting publ Examiner action	ication of SIR prior	r to	
Charge fee to the above-id	•		w, except for the filin	g fee	1805	1,840*	1805	1,840*	Requesting pub Examiner action	lication of SIR afte	r	
to the above-id			•		1251	110	2251	55	Extension for re	ply within first mor	nth	
			LCULATION	••••	1252	420	2252	210		eply within second		
1. BASIC F					1253	950	2253	475	Extension for re	ply within third mo	nth	
Fee Fee	Small Enti Fee Fee	<u> </u>	ee Description	Fee Paid		1,480	2254	740		ply within fourth m		
	Code (\$)		I BASSIA - ESS E -			2,010	2255			ply within fifth mor		
	2001 38 2002 17		Utility filing fee		1401	330	2401		Notice of Appea	_		
*	2002 17		Design filing fee	\vdash	1402	330	2402		• •	 support of an appe	eal	
			Plant filing fee		1403	290	2403		Request for ora			
			Reissue filing fee			1,510	1451		·	ute a public use pro	oceeding	
1005 160	2005 8		Provisional filing fee		1452	110	2452	•	Petition to revive		occeding	
		SU	JBTOTAL (1) (\$)	0.00								
2. EXTRA	CLAIM I	FEES	FOR UTILITY A	ND REISSUE		1,330	2453		Petition to reviv			
			Fee f	rom	1501	1,330 480	2501 2502		Utility issue feeDesign issue fe			
Total Claims							2502) Plant issue fee			
Independent	Independent 2** - Y					640 130	1460		Petitions to the	Commissioner		
Claims Multiple Depe	ndent				1460						7/~)	
Large Entity	<u> Small E</u>	ntity			1807	50	180		_	under 37 CFR 1.1		<u> </u>
Fee Fee	Fee	Fee	Fee Description		1806	180	1800			nformation Disclos		
Code (\$)	Code	•		20	8021	40	802	1 40	property (times	patent assignmen number of properti	ic pei ies)	
1202 18 1201 86	2202 2201	9 43	Claims in excess of a Independent claims in		1809	770	280			sion after final reje		
1203 290	2203		Multiple dependent o		1810	770	281	0 385	For each addition	onal invention to be	В	
1204 86	2204	43	** Reissue independ over original paten		1801	770	2801	385	examined (37 C Request for Co	CFR 1.129(b)) ontinued Examinati	ion (RCF)	
1205 18	2205	9	** Reissue claims in	excess of 20	1802		1802		D Request for ex	cpedited examination	•	
	•		and over original p		Other	fee (sp	- ecify)		of a design app	ліcauon		
***				0.00		• •		Filing F	ee Paid	SUBTOTAL (3)	(\$) 0.00	
		ıy paid,	if greater; For Reissu	es, see adove	1							
SUBMITTED	BY				£ ,	2a = i = 4 = =	tion At-			(Complete (if appli	icable))	
Name (Print/Typ	oe)	Wins	ton Hsu	1		Registra Attomev		41.	,526	Telephone 8862	289237350)

WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038.

unden Han

This collection of information is required by 37 CFR 1.17 and 1.27. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 12 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

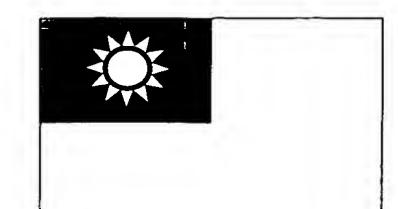


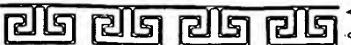
Approved for use through 10/31/2002. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

DECLARATION — Supplemental Priority Data Sheet

Additional foreign app	lications:			
Prior Foreign Application Number(s)	Country	Foreign Filing Date (MM/DD/YYYY)	Priority Not Claimed	Certified Copy Attached? YES NO
092100148	Taiwan R.O.C	01/03/2003		
·				
		•		

Burden Hour Statement: This form is estimated to take 21 minutes to complete. Time will vary depending upon the needs of the individual case. Any comments on the amount of time you are required to complete this form should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20231. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Assistant Commissioner for Patents, Washington, DC 20231.







中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

兹證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本、正確無訛、

其申請資料如下 : ()

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

西元 2003 年 01

Application Date

案 號 : 092100148 請

Application No.

人: 友達光電股份有限公司

Applicant(s)

Director General



2003 年 發文日期: 西元

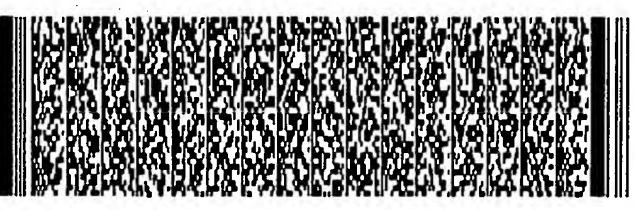
Issue Date

09220108080 發文字號:

Serial No.

申請日期:	IPC分類	
申請案號:		

(以上各欄	由本局填	發明專利說明書
		1X /4 1 11 10 /4 日
	中文	主動矩陣式顯示器之畫素結構
發明名稱	英文	PIXEL STRUCTURE OF AN ACTIVE MATRIX DISPLAY PANEL
	姓 名(中文)	1. 李純懷
	姓名(英文)	1. Li, Chun-Huai
發明人 (共1人)	─國 <u>─籍</u> (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所(中文)	1. 屏東縣萬丹鄉萬新路四八九號
	住居所(英文)	1. No. 489, Wan-Hsin Rd., Wan-Tan Hsiang, Ping-Tung Hsien, Taiwan, R.O.C.
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 友達光電股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. AU Optronics Corp.
=	國籍(中英文)	1. 中華民國 TW
甲請人 (共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	1. 新竹市新竹科學工業園區力行二路一號 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1. No. 1, Li-Hsin Road 2, Science-Based Industrial Park, Hsin- Chu City, Taiwan, R. O. C.
·	代表人 (中文)	1. 李焜耀
	代表人(英文)	1. Lee, Kuen-Yao
II III (74. 17.18284		



四、中文發明摘要 (發明名稱:主動矩陣式顯示器之畫素結構)

一種主動矩陣式顯示器之畫素結構,其包含有一儲存電容、一第一主動元件、以及複數個主動發光元件,其中該第一主動元件具有一第一端連接於一掃描線、一第二端連接於一資料線、與一第三端連接於該儲存電容,而該等主動發光元件係以並聯的方式電性連接於一第一電壓源、一第二電壓源、與該第三端之間。

伍、(一)、本案代表圖為:第 _6 _ 圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明

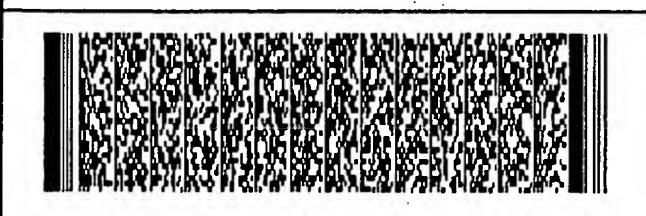
48掃描線50 資料線52畫素54 储存電容54a端點54b 端點56薄膜電晶體56a 閘極

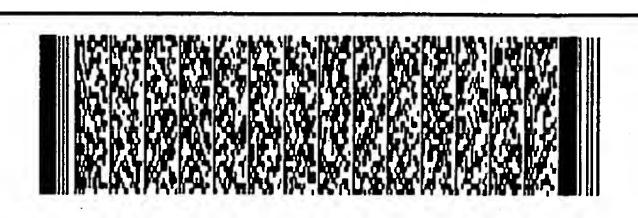
56b 汲極 56c 源極

58 主動發光元件 60 薄膜電晶體

六、英文發明摘要 (發明名稱:PIXEL STRUCTURE OF AN ACTIVE MATRIX DISPLAY PANEL)

A pixel structure of an active matrix display panel includes a storage capacitor, a first ctive device having a first end electrically connected to a scan line, a second end electrically connected to a data line, and a third end electrically connected to the storage capacitor, and a plurality of active type light emitting devices electrically connected in





四、中文發明摘要 (發明名稱:主動矩陣式顯示器之畫素結構)

60a 閘極 60c源 極

60b 汲 極

62 有機發光二極體

62a 陽極

陰 極 6 2 b

64 電壓源 66 電壓源

(發明名稱: PIXEL STRUCTURE OF AN ACTIVE MATRIX DISPLAY PANEL) 六、英文發明摘要

parallel with each other between a source of first potential, a source of second potential, nd the third end.



家(地區)申請專利 、□主張專利法第二十五條 申請案號:	之一第一項優	無案號 無權:		主張專利法	第二十四條	第一項優先
	之一第一項優	も權:				
	之一第一項優	も權:				
	之一第一項優	も權:				
	之一第一項優					
	之一第一項優					
	之一第一項優					
	之一第一項優					
	之一第一項優					
	之一第一項優					1
	之一第一項優					1
	之一第一項優		-			
申請案號:	-	fit .				
		血		-		
	•	7111				
日期:						
日期: 、□有關微生物已寄存於國 寄存國家:	外:					
寄存機構: 寄存日期: 寄存號碼:		無				
□有關微生物已寄存於國	內(本局所指定	之寄存機	構):			
寄存機構:	TO 100	· e_				
寄存日期:	·	無		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	
寄存號碼: □ 即 即 対 环 井 华 本 里	個 一工工 由 上	. :			• •	
□熟習該項技術者易於獲	付,个須奇仔。					
			.*			
R(7) L A) (A) 1(1) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C						
		• .				
		·				

五、發明說明(1)

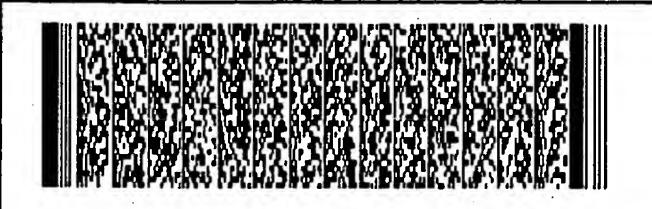
發明所屬之技術領域

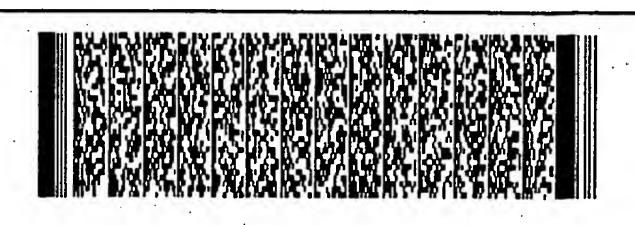
本發明係關於一種主動矩陣式顯示器之畫素結構, 特別是一種有機發光顯示器 (organic light emitting diode, OLED)之畫素結構。

先前技術

由於有機發光二極體具有省電、無視角限制、製造成本低、應答速度快、可操作的溫度範圍大、以及可隨下體設備小型化及薄型化等優點。因此,有機發光二極體在平面顯示器的系統中,具有極大的發展潛力,可望成為下一世代的平面顯示器。

請參考圖一,圖一為一習知有機發光顯示器 10的示意圖。有機發光顯示器 10包含一顯示面板 (display panel)12、一掃描線驅動電路 14以及一資料線驅動電路 16。其中,顯示面板 12上設置有複數條掃描線 (scanning line)18(即: SL₁~SL_m),複數條垂直於掃描線 18的資料線 (data line)20(即: DL₁~DL_n),以及複數個電性連接於掃描線 18與資料線 20的畫素 22。一般而言,掃描線驅動電路 14與資料線驅動電路 16會分別輸入訊號至掃描線 18與資料線 20上,以使各畫素 22依據影像資料而呈現不同的灰階來組成影像。





五、發明說明 (2)

請參考圖二,圖二為圖一所示之畫素 22的電路示意圖。如圖二所示,畫素 22包含有薄膜電晶體 24與 26、一儲存電容 28以及一有機發光二極體 30。其中,薄膜電晶體 24之 閘極 24a與汲極 24b係分別電性連接於掃描線 18與資料線 20,薄膜電晶體 26之閘極 26a係電性連接於薄膜電晶體 24之源極 24c與儲存電容 28之一端,且薄膜電晶體 26之源極 26c與汲極 26b分別電性連接到一外部電源 Vd與有機發光二極體 30之陽極 (anode)30a,而有機發光二極體 30之陰極 (cathode)30b接地。

一般而言,在操作各畫素 22時,掃描線驅動電路 14 會經由掃描線 18將一掃描信號輸入薄膜電晶體 24的 閘極 24a,以使薄膜電晶體 24處於導通狀態。接著,資料線驅動電路 16會經由資料線 20將一對應的資料信號輸入薄膜電晶體 24的 汲極 24b,以使薄膜電晶體 26處於導通狀態,此時,外部電源 V d會經由薄膜電晶體 26提供一驅動電流至有機發光二極體 30上,以使有機發光二極體 30產生相對應之亮度,並根據所通過之驅動電流大小產生不同灰階強度的光線。

請參考圖三與圖四,圖三係為圖二所示有機發光二極體 30的剖面示意圖,圖四係為圖三所示有機發光二極體 30的上視圖。如圖三所示,有機發光二極體 30主要包





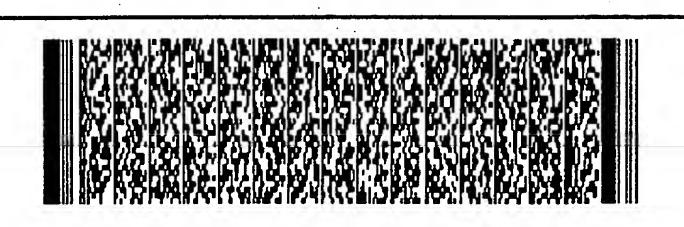
五、發明說明 (3)

含有一玻璃基板 32,一透明導電層 34設於玻璃基板 32表 面,用來當做有機發光二極體 30之陽極 30a,一複合薄膜層 36設於透明導電層 34之表面,以及一金屬層 38設於複合薄膜層 36表面,用來當做有機發光二極體 30之陰極。其中,複合薄膜層 36係由一電洞傳導層 (hole transporting layer)36a、一發光層 (light emitting layer)36b、以及一電子傳導層 (electron transporting layer)36c所構成。透明導電層 34包含有氧化銦錫 (indium tin oxide, ITO)或氧化銦鋅 (IZO)等材料,而金屬層 38包含有低阻抗之金屬或合金,例如鎂、鋁金屬二鋰/銀合金等。

需注意的是,因為製程的誤差或其他因素,金屬層 38與透明導電層 34有時會形成點接觸,而產生電性短路,例如:金屬層 38產生突尖 (Spike)而穿透複合薄膜層 36,並碰觸到透明導電層 34(圖三的 A點),或者是透明導電層 34因凹凸不平而與金屬層 38接觸 (圖三的 B點)。如圖三所示,由於 A點與 B點的電阻值約為數仟歐母 (KΩ),而有機發光二極體 30的電阻值約為數百萬歐母 (MΩ),因此大部份的驅動電流將會通過 A點與 B點,而使有機發光二極體 30無法正常地發光,因而成為有機發光顯示器 10上的壞點 (defect)。

如圆四所示,為解決前述問題,習知係利用雷射來





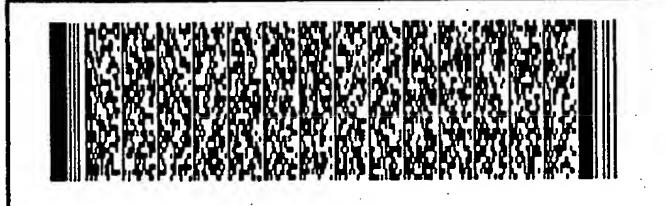
五、發明說明 (4)

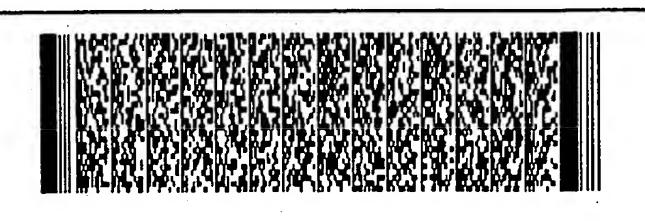
切除 A點與 B點,也就是利用雷射來切斷 A、 B點與有機發光二極體 30的連結部份。不過,雷射卻可能造成 A、 B點 問圍的金屬層 38與透明導電層 34接觸,導致電性短路,而無法有效修補有機發光顯示器 10上的壞點。另一方面,習知的修補方法必須經由作業員來找出壞點,然後再利用雷射逐一地修補壞點,不僅耗費人力與時間,更是不符合經濟效益。

發明內容

本發明的目的是提供一種主動矩陣式顯示器之畫素結構,以解決前述問題。

依據本發明之目的,本發明的較佳實施例係提供一種主動矩陣式顯示器之畫素結構,該主動矩陣式顯示器包含有一第一電壓源(source of first potential)與一第二電壓源(source of second potential),而該畫素結構包含有一儲存電容、一第一主動元件、以及複數個主動發光元件,其中該第一主動元件具有一第一端電性連接於一掃描線、一第二端電性連接於一資料線、與第三端包體存電容,而該等主動發光元件係以並聯的方式電性連接於該第一電壓源、該第二電壓源、與該第三端之間。





五、發明說明 (5)

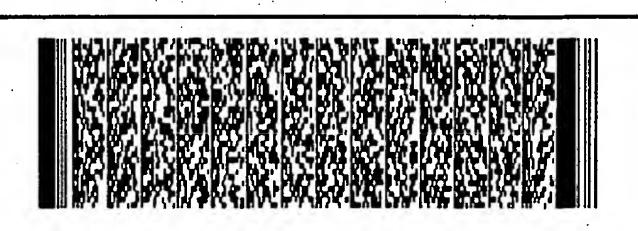
由於本發明之畫素係包含有複數個並聯的主動發光元件,且各該主動發光元件係包含有一發光元件以及一主動元件,用來提供驅動電流給該發光元件,以使該發光元件產生相對應的亮度。當該畫素內的其中一個(或複數個)發光元件發生電性短路時,該畫素係可經由其他的發光元件來產生光線,如此可省掉利用雷射修補壞點的步驟,以節省製程時間,進而可提昇產品良率。

實施方式

請參考圖五,圖五係為本發明之主動矩陣式顯示器40的示意圖。主動矩陣式顯示器40包含一顯示面板42、一掃描線驅動電路44以及一資料線驅動電路46。其中,顯示面板42上設置有複數條掃描線48(即:SL1~SLm),複數條垂直於掃描線48的資料線50(即:DL1~DLn),以及複數個電性連接於掃描線48與資料線50的畫素52。一般而言,掃描線驅動電路44與資料線驅動電路46會分別輸入訊號至掃描線48與資料線50上,以使各畫素52可根據影像資料呈現不同的灰階來組成影像。

請參考圖六,圖六係為圖五所示之畫素 52的電路示息圖。如圖六所示,畫素 52包含有一儲存電容 54、一主動元件 56、以及複數個主動發光元件 58。其中,各主動發光元件 58均係包含有一主動元件 60(T₁、T₂、T₃、T₄)與



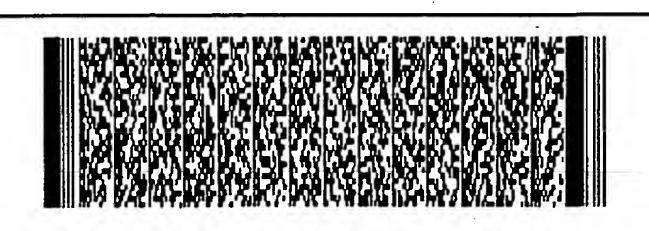


五、發明說明 (6)

一發光元件 $62(D_1, D_2, D_3, D_4)$, 且各主動發光元件 586 / 以並聯的方式電性連接於一電壓源 64、一電壓源 66、與儲存電容 54的端點 54 a之間。此外,電壓源 64係用來提供一電壓 V_1 ,而電壓源 66則是用來提供一電壓 V_2 ,一般而言,電壓 V_3 ,一參考電壓 (例如:接地),且電壓 V_4 通常係大於電壓 V_2 。並且,主動元件 56 與各主動元件 60 係包含有一薄膜電晶體或一互補式金氧半導體電晶體,而發光元件 62 則包含有一有機發光二極體或一發光二極體(light emitting diode,LED)。

在本發明之最佳實施例中,主動矩陣式顯示器 40係為一有機發光顯示器,因此,主動元件 56係為一薄膜電晶體,並且薄膜電晶體 56包含有一關極 56a電性連接於掃描線 48、一汲極 56b電性連接於資料線 50、以及一源極 56c電性連接於儲存電容 54的端點 54a。除此之外,各主動元件 60均係為一薄膜電晶體,而各發光元件 62則均係為一有機發光二極體。並且,各薄膜電晶體 60均具有一關極 60a電性連接至薄膜電晶體 56的源極 56c、一源極 60c電性連接至電壓源 64、以及一汲極 60b電性連接至有機發光二極體 62的陽極 62a,而有機發光二極體 62的陰極 62b則是電性連接於電壓源 66。另一方面,儲存電容 54的端點 54b係電性連接於電壓源 64,不過在本發明之其他實施例中,儲存電容 54的端點 54b也可以電性連接於任何一個可提供一固定電壓的電壓源。

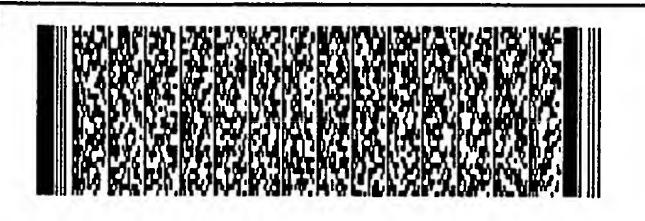


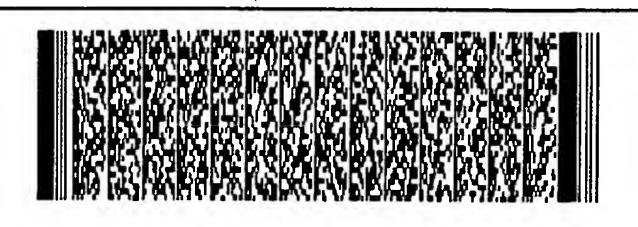


五、發明說明 (7)

再者,各畫素 52內部之操作方法係說明如下。首先,掃描線驅動電路 44會經由掃描線 48將一掃描信號輸入薄膜電晶體 56的開極 56a,以使薄膜電晶體 56處於導通狀態。接著,資料線驅動電路 50會經由資料線 50將一對應 60處於導通狀態,同時並對儲存電容 54進行充電 B 60均會處於導通狀態,同時並對儲存電容 54進行充電 B 60均會處於導通狀態,因此電壓不 64會經 62上, 使各有機發光二極體 62產生相對應之亮度。並且當薄膜電晶體 56關閉時,儲存電容 54仍具有該第一電壓,與使各薄膜電晶體 60維持在導通狀態,而可持續地提供驅動電流至各有機發光二極體 62上,以使各有機發光二極體 62上,以使各有機發光二極體 62上,以使各有機發光二極體 62上,以使各有機發光二極體 62上,以使各有機發光二極體 62上,以使各有機發光二極體 62上,以使各有機發光二極體 62工維持在發光狀態。

值得注意的是,當其中一個有機發光二極體 62 (例如: D_1)的陽極 62 a與陰極 62 b因為製程的誤差或其他因素,而產生電性短路時,則薄膜電晶體 T所提供的驅動電流無法使有機發光二極體 D發光。不過,如圖六所不,由於畫素 52內包含有四個並聯的主動發光元件 58,以此其它的薄膜電晶體 T_2 、 T與 T仍可提供驅動電流給有機發光二極體 D_2 、 D與 D_4 ,因此有機發光二極體 D_2 、 D與 D_4

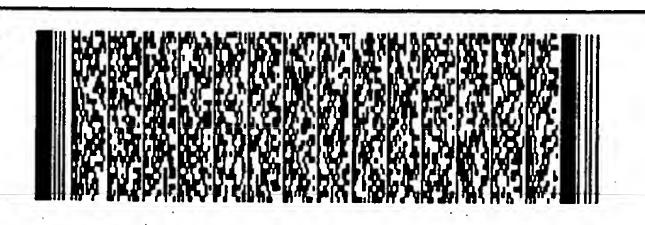


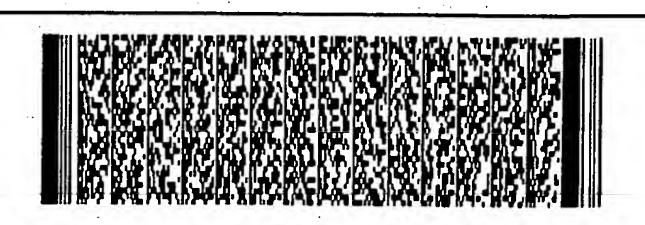


五、發明說明 (8)

說,任一個畫素 52只要具有至少一個良好的有機發光二極體 62,便可以正常地產生光線,如此一來,不僅可省掉利用雷射修補壞點的步驟,更可提昇產品的良率。

相較於習知技術,由於本發明之畫素係包含有複數個並聯的發光元件,且各該發光元件均與一主動元件串聯,各該主動元件係用來提供驅動電流給各該發光元件。因此,當該畫素內的其中一個(或複數個)發光元件發生電性短路時,該畫素內其它良好的發光元件仍可繼續發光,以使該畫素可正常地運作。如此一來,不僅可省掉利用雷射修補壞點的步驟,節省製程時間,進而可提昇產品良率。





五、發明說明 (9)

以上所述僅為本發明之較佳實施例,凡依本發明申請專利範圍所做之均等變化與修飾,皆應屬本發明專利之涵蓋範圍。



圖式簡單說明

圖示之簡單說明:

圖一係為一習知有機發光顯示器10的示意圖。

圖二係為圖一所示之畫素 22的電路示意圖。

圖三係為圖二所示有機發光二極體 30的剖面示意

圖

圖四係為圖三所示有機發光二極體30的上視圖。

圖五係為本發明之主動矩陣式顯示器 40的示意圖

圖六係為圖五所示之畫素 52的電路示意圖。

「 示之符號說明:

	•	-															
	1 0	有	機	發	光	顯	示	器		12	顯	示	面	板			
•	14	掃	描	線	驅	動	電	路		16	資	料	線	驅	動	電	路
••	18	掃	描	線		•	-			20	資	料	線		:		
	22	畫	素	•				. ·		24	薄	膜	電	日日	體		
	24a	閘	極	,						24b	汲	極					
	24c	源	極	•					•	26	薄	膜	電	日日	體		
٠	26a	閘	極		-		• •		· .* · .	26b	汲	極		• • .	. <i>.</i>		
	26c	源	極		•	·		•		28	儲	存	電	容	٠		
	30	有	機	發	光		極	體		30a	陽	極	•				
	30b	陰	極							32	玻	璃	基	板	:		
	34	透	明	導	電	層				36	複	合	薄	膜	層		
	36a	電	洞	傳	導	層				36b	發	光	層				
										•							

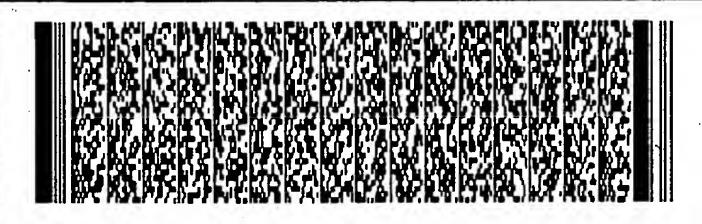


圖式簡單說明				
36c	電子傳	導 層	38	金屬層
4 0	有機發	光顯示器	42	顯示面板
4 4	掃描線	驅動電路	46	資料線驅動電路
48	掃描線		50	資料線
5 2	畫素		5 4	储存電容
54a	端點	•	54b	端點
5 6	薄膜電	記 體	56a	刷極
56b	汲 極	· ·	56c	源極
5 8	主動發	光元件	6 0	薄膜電晶體
60a	閘 極		60b	汲 極
60с	源 極		62	有機發光二極體
62a	陽 極		62b	陰 極
6 4	電壓源		6 6	電 壓 源
		•		

- 1. 一種主動矩陣式顯示器之畫素結構,該主動矩陣式顯示器包含有一第一電壓源 (source of first potential)與一第二電壓源 (source of second potential),該畫素結構包含有:
 - 一儲存電容;
- 一第一主動元件,其具有一第一端電性連接於一掃描線、一第二端電性連接於一資料線、與一第三端電性 連接於該儲存電容;以及

複數個主動發光元件,且該等主動發光元件係以並聯的方式電性連接於該第一電壓源、該第二電壓源、與第三端之間。

- 2. 如申請專利範圍第1項之畫素結構,其中該第一主動元件係為一第一薄膜電晶體,且該第一端係為該第一薄膜電晶體之間極,該第二端係為該第一薄膜電晶體之汲極,而該第三端係為該第一薄膜電晶體之源極。
- 3. 如申請專利範圍第1項之畫素結構,其中該儲存電容係電性連接於該第三端與一固定電壓源之間,且該固定電壓源係用來提供一固定之電壓。
- 4. 如申請專利範圍第3項之畫素結構,其中該固定電壓源係為該第一電壓源。



- 5. 如申請專利範圍第1項之畫素結構,其中各該主動發生光元件均各包含有:
- 一第二主動元件,其具有一第四端連接於該第三端、一第五端連接於該第一電壓源、與一第六端;以及
- 一發光元件,其具有一第七端連接於該第六端、以及一第八端連接於該第二電壓源。
- 6. 如申請專利範圍第5項之畫素結構,其中當該等發光元件之其中一個發生電性短路現象時,該畫素結構係可藉由其他之各該發光元件來顯示畫面。
- 7. 如申請專利範圍第5項之畫素結構,其中各該第二主動元件係包含有一第二薄膜電晶體或一互補式金氧半導體電晶體。
- 8. 如申請專利範圍第7項之畫素結構,其中該第四端係為該第二薄膜電晶體之間極,該第五端係為該第二薄膜電晶體之汲極,而該第六端係為該第二薄膜電晶體之汲極。
- O. 如申請專利範圍第5項之畫素結構,其中各該發光元件係包含有一有機發光二極體或一發光二極體。
- 10. 如申請專利範圍第9項之畫素結構,其中該第七端係



用來當作該發光元件之一陽極,而該第八端係用來當作了該發光元件之一陰極。

11. 一種主動矩陣式顯示器,其包含有:

複數條掃描線;

複數條資料線;

複數個畫素,且各該畫素均包含有:

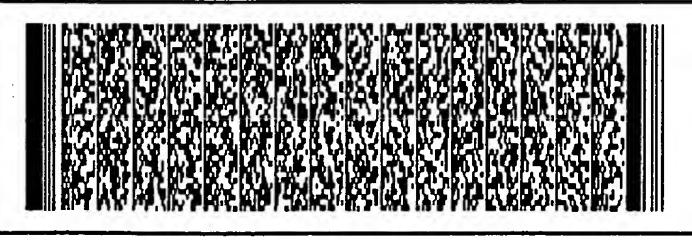
一儲存電容;

一第一主動元件,其具有一第一端連接至相對應之該掃描線、一第二端連接至相對應之該資料線、與一第 端連接至該儲存電容;以及

複數個主動發光元件,該等主動發光元件係以並聯的方式電性連接於一第一電壓源、一第二電壓源、與該第三端之間,且各該主動發光元件均各包含有:

一發光元件,其係電性連接至該第二電壓源;以及 一第二主動元件,其具有一第四端電性連接於該第 三端、一第五端電性連接至該第一電壓源、與一第六端 電性連接至該發光元件。

12. 如申請專利範圍第 11項之主動矩陣式顯示器,其中該第一主動元件係為一第一薄膜電晶體,且該第一端係為該第一薄膜電晶體之間極,該第二端係為該第一薄膜電晶體之汲極,而該第三端係為該第一薄膜電晶體之源極。

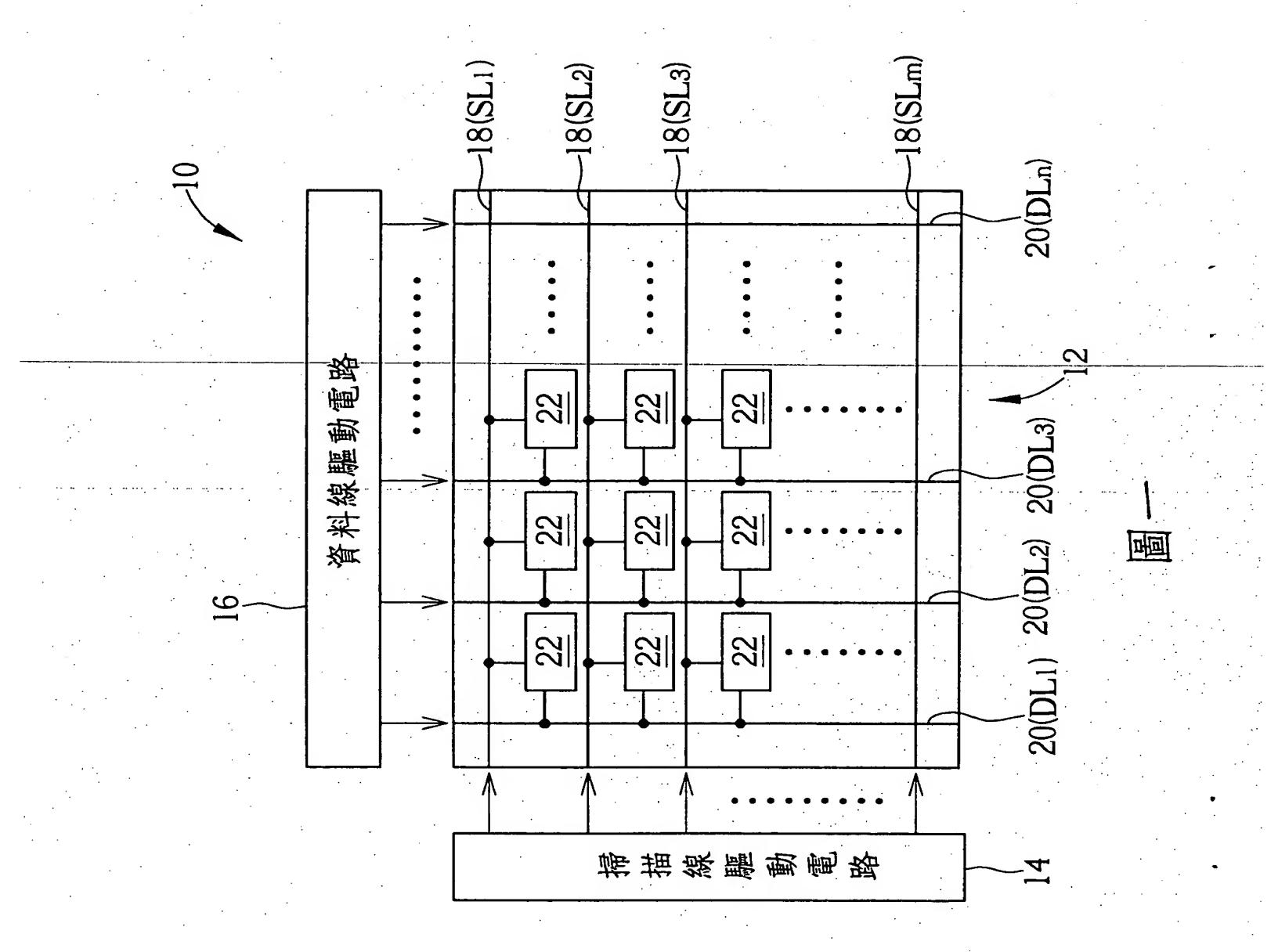


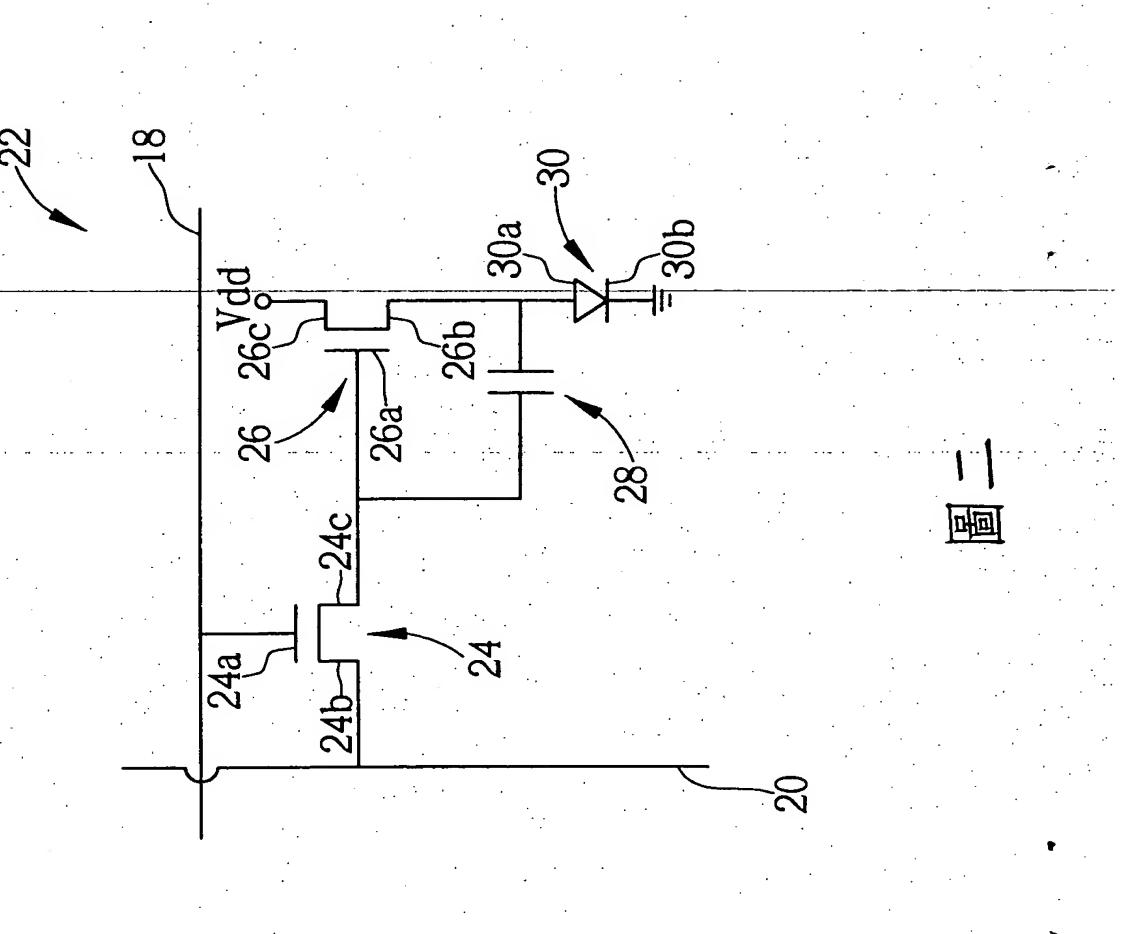
- 13. 如申請專利範圍第 11項之主動矩陣式顯示器,其中該儲存電容係電性連接於該第三端與一固定電壓源之間,且該固定電壓源係用來提供一固定之電壓。
- 14. 如申請專利範圍第13項之主動矩陣式顯示器,其中該固定電壓源係為該第一電壓源。
- 15. 如申請專利範圍第 11項之主動矩陣式顯示器,其中各該第二主動元件係包含有一第二薄膜電晶體或一互補金氧半導體電晶體。
- 16. 如申請專利範圍第15項之主動矩陣式顯示器,其中該第四端係為該第二薄膜電晶體之間極,該第五端係為該第二薄膜電晶體之汲極,而該第六端係為該第二薄膜電晶體之汲極。
- 17. 如申請專利範圍第 11項之主動矩陣式顯示器,其中各該發光元件係包含有一有機發光二極體或一發光二極體。
- 18. 如申請專利範圍第 11項之主動矩陣式顯示器,其中當一畫素內之其中一個發光元件發生電性短路現象時,該畫素係可藉由該畫素內之其他該等發光元件來顯示畫

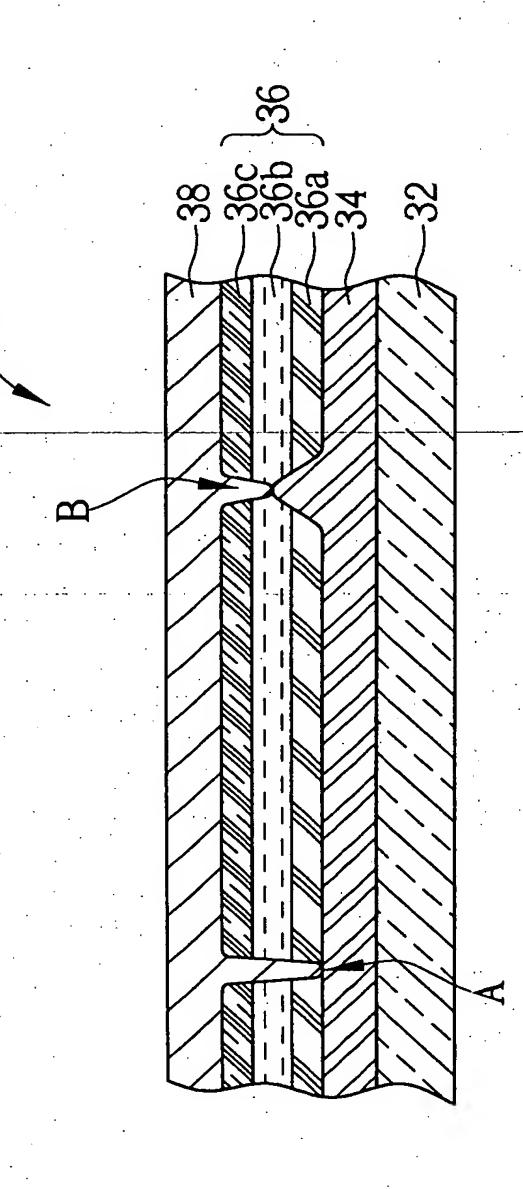


面。









. .





